総合報告

固体量子情報デバイスの現状と将来展望

万能ディジタル量子コンピュータの実現に向けて

阿部英介*,伊藤公平*,**

今,量子コンピュータが熱い.つい最近まで基礎科学と思われた 研究分野に,いつのまにか民間の資金が投入され,さまざまなエ ンジニアを巻き込んだ開発が急速に進んでいる.カナダのベン チャー企業 D-Wave Systems 社が,超伝導デバイスによる量 子アニーラを開発し,Lockheed Martin 社や NASA-Google 社のコンソーシアムへ販売したことはよく知られているし,D- Wave 社以外のベンチャー企業も次々出現している. さらに、米 国では Google, IBM, Intel, Microsoft といった IT, 半導体 産業のメジャー各社が量子コンピュータ開発に本腰を入れ始めた. 本稿では、量子コンピュータの究極の目標である万能ディジタル 量子コンピュータ研究を主題としてその現状を概観し、将来を展 望する.

1. まえがき

超伝導量子ビットを用いた量子コンピュータ研究の世界的 リーダである J. Martinis は、2015 年 2 月の講演で、1985 年 に参加した学会のことを回想している¹⁾. 当時、全くの無自覚 ながら超伝導量子ビットへつながる研究(後述)に足を踏み 入れていた Martinis は、招待講演をした R. Feynman が量子 コンピュータのアイデアについて語るのを聴いたものの、何を 言っているのかさっぱりわからなかったという. 30 年の時を経た 現在、量子情報科学は極めて多様な広がりをもつ学問へ発展 し、一時は夢のまた夢と思われた量子コンピュータ研究は、超 伝導、半導体、イオントラップ²⁾、冷却原子^{3,4)}、光^{5,6)} などの 系で、民間資金まで投入される開発フェーズに移行しつつある.

本稿のタイトルは「固体量子情報デバイスの現状と将来展 望」であるが、そもそも量子情報デバイスとは何か. ひと言で いえば、「量子力学に特有の原理(状態の重ね合わせや量 子もつれ)をリソースとして活用することで、それらなしでは原 理的に不可能なタスクを行うデバイス」となろう. このように定 義しても、今やその応用範囲は、量子計算^{7~10)}、量子通 信^{11~13)},量子中継^{14~18)},量子標準^{19~21)},量子計測・ センシング^{22~27)}と多彩である(分野の全体像は, 文献 28 を参照のこと). この中で、固体デバイスの活躍が最も期待さ れている分野が量子計算であることは、現在のコンピュータが 固体デバイス(シリコン CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)) で作られていることからも明らかだろう. と ころが、量子計算に限っても、現在では万能ディジタル量子 計算(いわゆるゲートモデルによる量子計算),アナログ量子 シミュレーション29), 量子アニーリング30) といった方式が林立 しており、全てをカバーすることは容易ではない.本稿では、

副題にあるとおり、万能ディジタル量子コンピュータの開発状 況に限って論じるが、その理由は単にトピックを絞るということ ではなく、その"万能"という単語のもつ意味にある.

ここで言う万能とは、「ほかの量子系で実現された量子計 算方式や量子アルゴリズムを任意の精度で再現できる」とい うことである.アナログ量子シミュレーションや量子アニーリング が特定のタスクに特化したデバイスとなるのに対して、万能 ディジタル量子コンピュータは、それ「も」できる"何でも屋" なのである.もちろん、人間が作るデバイスが、実際にそのよ うな万能性を獲得しうるかは全く非自明であり、現在のすばら しい研究の進展を目の当たりにしても、全く楽観視はできな い.それを理解したうえで、万能ディジタル量子コンピュータ (以下、量子コンピュータ)という究極の目標に立ち向かう先 端研究の現場を伝えるのが本稿のねらいである.

2. エラー耐性量子コンピュータへの道

量子コンピュータは、計算単位として量子 2 準位系(量子 ビット^{†1})を用い、重ね合わせ(α |0>+ β |1>)や量子もつれ (例えば、(|00>+|11>)/ $\sqrt{2}$)という量子系に固有の状態を 計算に活用する.量子コンピュータ実現に向けた困難もまさに この点、量子状態を量子状態のまま保持する(量子コヒーレ ンス^{†2}を保つ)ことの難しさにある.幸いにして、原理的には 量子コヒーレンスを永続させる方法があることがわかっており、 量子エラー訂正(Quantum Error Correction: QEC)と呼ば れている.QECにはいくつかの方式があるが、基本的なアイ デアは古典のエラー訂正と同様に、1つの量子ビット(しばし ば物理ビットと呼ばれる)の量子情報を、複数の量子ビットか らなる論理ビットに埋め込むことにある(3.4節で具体例を述

*慶應義塾大学 スピントロニクス研究センター 〒223-8522 横浜市港北区日吉3-14-1. ** 慶應義塾大学 理工学部物理情報工学科 〒223-8522 横浜市港北区日吉3-14-1. 分類番号 12.6, 4.4

e-mail: kitoh@appi.keio.ac.jp

Current status and future prospects for solid-state quantum information device development to realize digital universal quantum computing. Eisuke ABE^{*} and Kohei ITOH^{*,**}.

^{*} Spintronics Research Center, Keio University (3-14-1 Hiyoshi, Kohoku-ku, Yokohama 223-8522)

^{**} Department of Applied Physics and Physico-Informatics, Keio University (3-14-1 Hiyoshi, Kohoku-ku, Yokohama 223-8522)

べる). QEC を逐次実行しながら量子計算を行うことができる 量子 コンピュータは,エラー耐性を備えている(faulttolerant)と呼ばれる.エラー耐性量子コンピュータに至る開 発の道筋を,図1に示す³¹⁾.研究が最も進んでいる超伝導 とイオントラップの系では,複数の量子ビットによって論理ビッ トを構成し,その論理ビットの寿命(T_1),コヒーレンス時間 (T_2)を,もともとの構成要素の $T_{1,2}$ よりも長くするという,第 4 段階の研究開発が進行している.

一般に、系がエラー耐性を獲得するのに許容されるエラー 率と、1 論理ビットを構成するのに必要な物理ビット数にはト レードオフがある。例えば、表面符号(surface code)と呼ば れる QEC 方式では、エラー率1%でも QEC が可能である が、その場合には1 論理ビット当たり10⁴ 個の物理ビットが必 要となる。一方、エラー率を0.001%に抑えることができれ ば、1 論理ビット当たり170 個の物理ビットで済む³²⁾.した がって、技術開発が図1の上層へ進んでも、下層の基礎技 術の精度を高めていく研究も同様に重要となる。

では、実際に意味のある(古典コンピュータを凌駕する) タスクを行うのに必要な論理ビット数は、どの程度か.現在の 素因数分解の世界記録は、RSA-768(768ビット、~10²³²) を演算ステップ10²⁰回、2年間かけて実行したものである³³⁾. 一方、768ビットの素因数分解をエラー耐性量子コンピュータ で実行するためには、論理ビット1154個、論理ビットの演算 ステップ10⁶回程度が必要となる^{34~36)}.すなわち、論理ビッ ト演算のクロック周波数が1Hz(この間に相当数の物理ビット 演算が行われる)でも、半月足らずでRSA-768の素因数分 解が可能となる.

固体デバイスで量子計算を行う際にまず問題となるのは、 コヒーレンスである. 真空中に保持された原子・イオン系と異 なり、固体は相互作用の宝庫であり、その大半がデコヒーレ ンスを誘発する. この点で、外界との相互作用が弱く、バル ク材料でもともとコヒーレンス時間が長いことが知られていた半 導体中のスピンを用いることは自然な発想である. 一方、量 子 2 準位系そのものを人間がデザインする超伝導デバイスで は、良質のコヒーレンスを得られる保証は全くなかった. 以下 では、超伝導量子ビットとシリコンスピン量子ビットを取り上げ、



図1 7段階の量子コンピュータ開発の道筋³¹⁾

いかにして多くの困難が乗り越えられたか、そして今後乗り越 えるべき困難は何かについて解説する.

3. 超伝導量子ビットの開発状況

超伝導量子ビットは、近年、あらゆる量子系の中でも最も 劇的な進展を遂げ、量子コンピュータ研究の最前線に位置し ている.その研究の歩みは、おおまかに3つのフェーズに分 けることができる. 2003年頃までは、超伝導量子ビットの開発 期で、電荷・位相・磁束という異なる自由度を用いて、タイ プの異なる複数の超伝導量子ビットが開発された. 2004 年に 導入された回路量子電磁力学^{†3} (Circuit Quantum Electrodynamics:回路 QED)のアイデアにより、マイクロ波光子を 用いた量子光学実験や、2~4 量子ビット系の高精度制御が 実現し、多量子ビット化に向けた礎が築かれた.原子・イオ ン系に追いつき、ある面では追い抜いた、基礎研究の発展期 といえる. そして 2014 年, 米国カリフォルニア大学サンタバー バラ校 (UCSB) の Martinis グループは, 直列結合の5量 子ビットデバイスにおいて、1量子ビットゲートの忠実度(fidelity) 99.92%, 2量子ビットゲートの忠実度 99.4%, 測定 忠実度 99% を達成したことを報告した37). これらの値は、 表面符号 QEC によって、系がエラー耐性をもつために必要と される忠実度 99%を上回っており、このまま系をスケールアッ プできれば, エラー耐性を備えた量子コンピュータが実現する ことを意味する. もちろん, 実際に系をスケールアップするに は、まだまださまざまな困難が待ち構えているが、多くの研究

^{*1} **量子ビット** 古典計算では、データの単位として0と1の2値(ビット)を用いるのに対し、量子計算では、量子力学的な2準位 |0>、|1> にデータ(量子情報)を格納するため、この量子2準位系を量子ビットと呼ぶ、量子ビットの状態としては、|0> と |1>の重ね合わせ状態 $a|0> + \beta|1>$ をとることができる($a \ge \beta$ は、 $|a|^2 + |\beta|^2 = 1$ を満たす複素数).スピン1/2の上向きスピン状態 (↑)、下向きスピン状態 $|\downarrow>$ は、"天然"の量子ビットである。一方、原子、イオン、超伝導デバイスなどでは、エネルギースペクトルは2つ以上の準位からなることがほとんどである。その場合でも、適切な2準位を選び出すことで(多くの場合、基底状態と第1励起状態)、実効的な量子2準位系を構成できる。このような有効2準位系を擬スピンと呼ぶこともある。

^{†2} 量子コヒーレンス 量子ビットを基底状態 |0> と, それよりエネルギーの高 い状態 |1> から構成した場合, |1> 状態は,時間がたつとエネルギーを放出 して |0> 状態へと緩和する. この時定数を,量子ビットの寿命,緩和時間, T_1 などと呼ぶ.一方,重ね合わせ状態(|0>+|1>)/ $\sqrt{2}$ は, "0 であり,かつ1で

もある"という量子系に特有の状態(量子コヒーレンスのある状態)であるが、 時間とともに、"0または1"という古典状態へと変わる(より正確には、状態の 密度行列の非対角成分が失われる).量子状態が"古典化"する過程をデコ ヒーレンスと呼び、その時定数をコヒーレンス時間、 T_2 などと呼ぶ、実験的に T_2 を決定するためには、測定ごとの不均一性を取り除くためにスピンエコー法と 呼ばれる技術を用いる.共鳴線幅から見積もられる T_2 は不均一性を含んでいる ため、 T_2^* としてスピンエコー法で得られた T_2 と区別することが多い、この場 合、 T_2^* は T_2 の下限値と見なされる.

^{†3} **量子電磁力学** 電磁気相互作用を記述する場の量子論. 量子電気力学とも 呼ばれる. その最も単純化された例は, 原子の2準位系と単一の電磁波モード からなる系である. 高Qの共振器内に原子と電磁波を閉じ込めることでこの系を 実現し, 原子 - 光子相互作用の過程を詳細に調べる研究分野が, 共振器量子 電磁力学である.

者が抱いていた,量子コンピュータの実現性に対する心理的 バリヤを取り除いたといえる.これは,資金を提供する側に とっても同様であったようで,同年にITの巨人 Google 社が, Martinisのグループごと雇用して研究を支援することを発表し た.こうして現在は,数十~百量子ビットの中規模量子コン ピュータ実現に向けた研究が本格化した第3期を迎えている.

本章では、まず、超伝導量子ビットの基礎について解説し、 第1、2期の研究を振り返る.その後、現在の第3期の研究 動向について解説する.

3.1 基礎知識

超伝導デバイスにおいては、ジョセフソン接合に付随する異 なる自由度を用いることで、電荷量子ビット、位相量子ビット、 磁束量子ビットと呼ばれる、性質の異なる量子ビットを実現で きる.後述するトランズモン(transmon)は、電荷量子ビット の亜種である.ジョセフソン接合は、超伝導体を極薄の絶縁 体で隔てた構造であり、電気回路的には、無散逸の非線形 インダクタと、キャパシタの並列回路として機能する.通常の (線形) LC 回路のハミルトニアンを考えると、

$$H = \frac{Q^2}{2C} + \frac{\Phi^2}{2L} \tag{1}$$

となる. Qはキャパシタにたまる電荷, ϕ はインダクタのコイル を貫く磁束である. 式(1)は, 運動量 p, 位置 x をもつ調和 振動子の系のハミルトニアン($H = p^2/2m + kx^2/2$)と同じ形を しているから, LC 回路を"量子化"するには, $Q \ge \phi$ を共 役演算子と見なして, 交換関係 $[\hat{Q}, \hat{\phi}] = i\hbar$ を課せばよい (詳細は文献 38 を参照のこと). 調和振動子の場合と同様 に, 等間隔のエネルギー準位構造が得られる.

準位が等間隔では、周波数による遷移の識別ができないの で、量子ビットとして用いるには都合が悪い.そこで、ジョセ フソン接合の非線形性を導入する.それには、式(1)の第2 項を $-E_1 \cos(2e\Phi/\hbar)$ と置き換える(より詳細な議論と、 ϕ と超伝導の位相との関係などは、例えば文献 39 を参照のこ と). E_1 はジョセフソンエネルギーと呼ばれる.コサインの ϕ^4 以上の項が非調和ポテンシャルを生み、マイナス符号により、 高エネルギーになるほど準位間隔が狭くなる.これにより、最 低エネルギー状態 |0>と第1励起状態 |1>の間の遷移の みに周波数識別してアクセスすることが可能となり、量子ビッ トとして活用することができる.

 E_J は ϕ に付随するエネルギーであるが、Q、すなわち式 (1)の第1項に付随するエネルギーは、帯電エネルギー E_c である.ただし、 E_c の計算には、接合のキャパシタンスだけ でなく、ゲート電極やグラウンドとの間にできるキャパシタンスも 含めた、系全体のキャパシタンスを用いる.すると、超伝導量 子ビットは E_J と E_c の比によって分類できる. E_J/E_c が1以 下では、帯電効果が支配的であり、電荷量子ビットと呼ばれ る.一方、 E_J が支配的となるデバイスは、位相量子ビットと 呼ばれ、 E_J/E_c は10⁴程度になっている.磁束量子ビットを 実現するには、SQUID (Superconducting Quantum Interference Device)のループ構造を導入する. ループの右回り と左回りの電流が、向きの異なる磁束の状態を生むので、量 子ビットとして用いることができる. 磁束量子ビットにおける *E*_J/*E*_c は数十程度であり、電荷量子ビットと位相量子ビットの 中間の値となるが、「右回りと左回りの電流の重ね合わせ状 態」が実現すると考えれば、巨視的量子性という点では、最 も劇的なものである.

ここまでの議論は,超伝導量子ビットの解説の定番の導入 部であるが,無論,電気回路の量子化とそのエネルギー構造 の離散化,右回りと左回りの電流の重ね合わせといった概念 が,はじめから受け入れられていたわけではない.むしろ,こ うした概念への実験的な答えを見いだす研究こそが,超伝導 量子ビットの実現につながっていったのである.

3.2 第1期:量子ビット開発

SQUID ループの右回りと左回りの電流の間に,量子力学 的な重ね合わせ状態が可能か,という問いを定式化したの は,米国イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校の A. Leggett である⁴⁰⁾. 1980 年代の超伝導メゾスコピック系の研究水準 は,この問いに答えるところまで成熟してはいなかったものの, 研究者たちはその前段階として理解されるべき,巨視的変数 の量子性,それによって形成される離散エネルギー準位の存 在,その準位における巨視的量子トンネル現象の観測といっ た課題に取り組んでいった.

1985年、カリフォルニア大学バークレー校 J. Clarke グルー プの大学院生であった Martinis は、ポスドクの M. Devoret と ともに、マイクロ波分光を用いて、電流バイアスされたジョセ フソン接合(いわゆる洗濯板ポテンシャルをもつ)におけるエ ネルギー準位の離散化を確認した⁴¹⁾. このことは、ジョセフソ ン接合で隔てられた超伝導体の間の位相差という巨視的変数 が量子性をもつことを意味し、また今日的な視点からは、位 相量子ビットの元祖と見なすこともできる. その後、Devoret は母国フランスに戻り、同時期に Clarke グループに在籍して いた D. Esteve, C. Urbina とともに、超伝導量子エレクトロニ クス(彼らは "Quantronics" と呼んでいる) グループをサク レー研究所に立ち上げ、同分野の世界的リーダとなった. Martinis は、Quantronics グループのポスドクを経て米国立標 準技術研究所(NIST) に移り、やはり同分野の研究を続けた.

1990年代に入ると、微細加工技術と薄膜作製技術はさら に進歩し、大きな E_c を有する極微小な単電子トランジスタ (Single Electron Transistor: SET)の作製が可能となった. このような超伝導 SET はクーパー対箱とも呼ばれ、ゲート電 圧を調節することで、内部の余剰クーパー対の数Nを制御で きる. さらには、余剰電荷N(2e)と(N+1)(2e)の状態が、 エネルギー的に縮退するようにゲート電圧を設定することもで きる. 系が量子力学に従うのであれば、このときの2状態は、 結合・反結合状態を形成して縮退が解ける(エネルギー差 E_1 の準位反交差)はずである. 1997年、日本電気(株) (NEC)基礎研究所の中村泰信、蔡兆申らは、この「電荷 の重ね合わせによるエネルギー分裂」を、マイクロ波分光により確認した⁴²⁾. これは、1985年の実験の電荷版に対応する. さらに 1999年、NEC グループは電圧パルスを用いて、電荷 の結合・反結合状態の間のコヒーレント振動を観測した⁴³⁾. 真の意味での超伝導量子ビット(電荷量子ビット)の誕生で あり、その後の研究の火付け役となった記念碑的な実験である.

しかしながら、この時点での量子ビットの T_2 は 1 ns 程度で あり、その後 10 年の研究は、デコヒーレンス要因の解明、デ コヒーレンスを抑制するマイクロ波パルス技術(エコー法やダ イナミカルデカップリング)、ノイズに対して頑強な量子ビットの 設計とその実現が大きなテーマとなる(図 2). 電荷量子ビット に対しては、NEC グループにより、ラビ振動の観測⁴⁴⁾、電荷エ コーによるコヒーレンスの延伸(T_2 =3 ns)⁴⁵⁾ などが行われた.

この研究に触発された Martinis らは、改めて位相量子ビットをデザインし、2002年、そのラビ振動を報告した⁴⁶⁾ (Martinis は 2004年に UCSB に移籍).同年、Quantronics グループは、電荷量子ビットと位相量子ビットの中間 ($E_J/E_c\sim5$)の性質をもつ"Quantronium デバイス"を開発 し、さらに、ノイズに対して頑強な最適動作点と呼ばれる動作 条件を用いることで、 $T_1=1.8 \mu s$, $T_2=500 ns$ を達成し た⁴⁷⁾.固体系は、原子系と比べてはるかに複雑でダーティで あり、デコヒーレンス要因を突き止めることは容易ではない.一 方、系の適切なデザインによってコヒーレンス特性を劇的に改 善できることは、デバイス設計の自由度が高い固体系ならで はといえる.2003年には、オランダ・デルフト工科大学(TU Delft)の H. Mooij グループによって、SQUID ループ構造を 用いた磁束量子ビットのコヒーレント制御が報告された⁴⁸⁾.

こうして、基本的な超伝導量子ビットが出そろったが、得ら れた T_2 は、位相量子ビットで 10 ns、磁束量子ビットで 30 ns 程度であった.また、その時点で実現していた 2 量子ビットデ バイスの構造^{49,50)}をそのまま 3 量子ビット以上へ拡張すること には、大きな困難が横たわっていることは明らかであった.

3.3 第2期:回路QED

超伝導量子ビット研究の第2期の幕開けとなる革新は、 2004年に訪れる.米国イェール大学のR.Schoelkopfグルー プは、超伝導量子ビットを原子、コプレーナ線路共振器を空 洞共振器に対応させ、系を精緻に設計することで、原子物理 における共振器 QED のエレクトロニクス版、回路 QED を行う ことを提案し⁵¹⁾、単一電荷量子ビットと単一マイクロ波光子の 強結合状態を実現してみせた⁵²⁾.強結合状態とは、原子 – 光子相互作用定数 g が、原子と共振器光子のデコヒーレンス レート γ 、 κ のいずれよりも十分大きい状態($g^2 \gg \gamma$, κ)を指す. 原子系では、その実現に最先端の技術と多大な労力を要する 強結合状態が、巨大な電気双極子モーメントをもつ超伝導量 子ビットでならばあっさりと実現できることは、コロンブスの卵 ではあるが見事というほかない.

Schoelkopf は、米国航空宇宙局(NASA)ゴダード宇宙飛行センターで電子工学・低温技術者として勤務した経歴もあ



図2 電荷量子ビットの T_{12} の変遷. $T_2 \ge T_2^*$ を区別しない. 横軸は論文の出版年. "Yale Cat" は共振器光子に対する結果. NEC^{43,45)}, Saclay⁴⁷⁾, Yale cQED⁶³⁾, Yale Transmon⁶⁵⁾, Yale 3D⁶⁸⁾, IBM 3D⁷⁰⁾, Yale Cat⁶⁹⁾.

る実験物理学者である. 1998 年に Schoelkopf らによって開発されたラジオ波 SET の技術⁵³⁾ は、現在では半導体量子 ビットの高速読み出しに援用され⁵⁴⁾、量子情報実験に不可欠 な技術となっている. 超伝導量子ビットの研究でも、回路 QED をはじめとする多くの独創的なアイデアを提供して、分野 全体に大きな貢献をしている. また、Devoret は 2002 年に イェール大へ移籍し、以来、Schoelkopf と共同研究を行って いる. 次節で述べる第3期の研究を、Schoelkopf、Martinis とともに牽引している中堅・若手 PI(Principal Investigator) の多く(スイス連邦工科大学チューリッヒ校の A. Wallraff、TU Delft の L. DiCarlo (Mooij の後任)、米国 IBM ワトソン研究 所の J. Chow と J. Gambetta など)が、この第2 期に Schoelkopf, Devoret の下で研鑽を積んでいる.

回路 QED がもたらした革新は、大きく3 つある.第1に、 制御性の高い系での量子光学実験が可能となった.*g*, γ , κ , および量子ビットの周波数 ω_q , 共振器モード周波数 $\omega_r を$ デザインすることにより、原子系では実現できないような実験 条件をも実現できる. この方面の研究を詳述するスペースはな いが、重要な成果として、マイクロ波単一光子生成(イェー ル大)⁵⁵⁾、単一電荷量子ビットを用いたメーザー発振 (NEC)⁵⁶⁾、光子数状態生成と任意の光子数重ね合わせ状態 の"合成"(UCSB)^{57,58)}、超強結合領域(ultrastrong, *g*~ ω_r)の観測(ドイツ・ヴァルター・マイスナー研究所)⁵⁹⁾ などが挙げられる. 興味のある読者は、文献 60 を参照され たい. またごく最近では、深超強結合領域(deep ultrastrong, *g*> ω_r)の観測まで報告されている^{61,62)}.

第2に、量子ビットの量子非破壊(Quantum Nondemolition: QND)測定⁶³⁾、共振器を介した複数量子ビットの結 合⁶⁴⁾ といった量子コンピュータに重要な技術が、自然な形で 実現できるようになった.量子ビットの QND 測定は、QEC の エラー検出に不可欠な最重要技術であり、以下のように実現 される.量子ビット周波数が、共振器モードから離調された非 共鳴条件 ($\Delta \equiv |\omega_q - \omega_r| \gg g$,強分散領域と呼ばれる)での 系の有効ハミルトニアンは

$$H = \hbar \omega_{\rm r} a^{\dagger} a + \frac{\hbar}{2} \left(\omega_{\rm q} + \frac{g^2}{\Delta} \right) \sigma_{\rm z} + \hbar \frac{g^2}{\Delta} a^{\dagger} a \sigma_{\rm z} \tag{2}$$

となる. 第3項は、いわゆるACシュタルク効果に相当する が、光子数($a^{\dagger}a$)と量子ビット状態(σ_{2})の両方に依存する形に なっている. 量子ビットの状態が |0>か |1>かで相互作用 の符号が変わり、光子の周波数が $\omega_{r}\pm(g^{2}/\Delta)$ と変化する. これにより、光子の周波数シフトから量子ビット状態の QND 測定が可能となる. 重要なこととして、式(2)は光子と量子 ビットに対して対称な形をしている. よって、量子ビットの周波 数シフトから光子数の QND 測定を行うことも可能である. ま た複数量子ビットの結合も、共振器と量子ビットは非共鳴の状 態で行い、量子ビット間の周波数差を調節することで、仮想 光子を介した量子ビット間の結合を実現している.

第3に、量子ビットのコヒーレンスが大幅に改善した. 図2 にあるように、第1世代の回路 QED に用いられたクーパー対 箱は、すでに Quantronium と同程度のコヒーレンスを備えて いる⁶³⁾. 従来、超伝導量子ビットの読み出し機構は複雑にな りがちであった. 例えば、電荷量子ビットでは、クーパー対箱 に読み出し用の高抵抗接合がつながっており、準粒子電流を 測定している. 磁束量子ビットでは、量子ビットの SQUID に 近接して読み出し用の SQUID が必要となる. こうしたデバイ スの複雑さが、量子ビットのコヒーレンスを制限する要因となっ た側面もあるだろう. 回路 QED では、基本的にはマイクロ波 の入出力のみで量子ビットの制御・測定を行うことができるの で、デバイス構造を簡略化でき、結果としてコヒーレンスの改 善にもつながった.

さらに、回路 QED のためにイェール大グループによって開 発されたトランズモン量子ビットにより、ついに(ようやく?)、 1 µs を超える T_2 が実現された(T_1 =1.9 µs, T_2^* =2.2 µs)⁶⁵⁾. トランズモンは、ジョセフソン接合を含むアイランドがコプレー ナ線路の信号線とグラウンド線をシャントする構造をしており、 非常に大きいキャパシタンスをもつ. E_J/E_c はQuantroniumよ りはるかに大きい、数十となり、エネルギー分散が電荷に対し てほぼ平坦となるため、電荷ノイズに強い耐性を備える.トラ ンズモンは、この後の超伝導量子ビットのスタンダートとなっ た.トランズモンを用いて、2量子ビット量子アルゴリズム⁶⁶⁾、 3量子ビットの量子もつれ生成⁶⁷⁾ などの実験が行われた.

イェール大グループは、サファイヤ基板上に作製したトラン ズモンを3次元空洞共振器内に配置することで、コヒーレンス のさらなる改善を行った($T_1 = 60 \mu s$, $T_2 = 25 \mu s$)⁶⁸⁾. この場 合のトランズモンは、100 nm 四方程度のジョセフソン接合に 対して、数百 μm サイズの超伝導薄膜のアンテナ構造となって いる. また、共振器のQ 値を上げることは比較的容易なた め、光子状態を量子メモリとして用いることも可能となり、1 ms を超える T_2 が得られている⁶⁹⁾. 光子状態を量子メモリと して使うというアイデアは、光子のQND 測定と合わせて、次 節で述べる"猫符号 (cat code)"の開発へとつながった.

IBM グループは、3 次元共振器を用いたアプローチで T₁

回路 QED を採用しつつ、量子ビットとしては位相量子ビット を用いていた UCSB グループは、前述の量子光学実験のほ か、4 量子ビットの簡易版素因数分解量子アルゴリズムを実 行するなど⁷²⁾、目覚ましい成果を挙げたが、2013 年につい にトランズモンへ移行した。ただし、独自の改良を加え、その 十字型の形状からエックスモン(Xmon)と名付けている⁷³⁾. その最大の特徴は、長いコヒーレンス時間(*T*₁=44 µs, *T*₂ =20 µs)と高い制御性(量子ビット周波数の調整機能,量子 ビット間の直接結合など)、拡張性を兼ね備えた点である。設 計面での改良だけではなく、超伝導薄膜の分子線エピタキシ 成長を導入するなど材料科学面での改善も図っている。彼ら の本気度がうかがえる。本節の冒頭に述べた直列結合の5 量子ビットデバイスの成果³⁷⁾は、その直接的な帰結である。 こうして、第3期の幕が上がった。

3.4 第3期:QECの実装へ向けて

第2期に,超伝導量子ビットの研究は多様な広がりを見 せ,研究者人口は大きく増加した.今後も,基礎研究分野に おいては,興味深い成果がさまざまな研究グループによって報 告されるだろう.一方,量子コンピュータ研究の視点からは, 新たな研究フェーズの主眼は,QECの実装とその延長として の中規模量子コンピュータの実現である.このような真に挑戦 的な道を進むとなると,設備・人材の両面で多大な投資が必 要となるため,プレーヤの数は絞られてきている.

本稿を執筆している 2017 年 1 月時点では, Martinis 率い る Google-UCSB グループ, Schoelkopf 率いるイェール大グ ループ, DiCarlo 率 いる TU Delft グループ, Chow と Gambetta 率いる IBM グループの 4 グループが主要プレーヤ である. ほかにも, カリフォルニア州に拠点を置くベンチャー企 業の Rigetti Computing 社 (CEO の Chad Rigetti は, イェー ル大と IBM 社で超伝導量子ビットの研究を行っていた)が, 超伝導デバイスによるディジタル量子コンピュータの製品化を 狙っているが, まだ具体的な成果は公表されていないので, 以下では触れない.

いずれのグループもトランズモンを採用しているが、QEC へ のアプローチは異なる(図3).Google-UCSB グループは、 エックスモンを用いて表面符号に取り組んでいる.各エックス モンは、磁束バイアスを用いて個別に周波数を制御可能であ り、量子ビット間の結合は直接的な静電結合である.9量子 ビットが稼働しており、さらなる多量子ビット化を進めている. IBM グループも表面符号を採用しているが、トランズモンの周 波数は固定で、量子ビット間の相互作用はコプレーナ線路共 振器を介して実現する.5量子ビットが稼働しており、このデ バイスをウェブ上でテストすることのできるクラウドサービスを提 供している⁷⁴⁾.ユーザが量子回路をデザインすることも可能 で、非 IBM グループがこのサービスを利用して量子計算を行



図3 QEC の方式. (a)スタビライザ符号. (b)表面符号. (c)猫符号. 赤と青の模様は各状態のウィグ ナー関数のイメージ.

い、学術論文を出版している事例もある^{75,76)}. TU Delft グ ループは、周波数可変のトランズモンをコプレーナ線路共振 器経由で相互作用させる方式を採用している. 最新のデザイ ンでは、各トランズモンに、結合用共振器×4、測定用共振 器、マイクロ波ライン、周波数制御のための磁束バイアスライ ンと計7つの信号線がつながっており、構造としては一番複 雑である⁷⁷⁾. その星型の形状からスターモン(starmon)と呼 ばれている. QEC 方式としては、表面符号が念頭にあるが、 小規模での実装ではスタビライザ符号も視野に入れている. 最後に、イェール大グループは3次元共振器を用いて猫符号 による QEC を進めており、独自路線を歩んでいる. ただし猫 符号は、原理的には表面符号やほかの QEC 方式との併用が 可能であり、例えば、猫符号による論理ビットが忠実度 99. 999%を達成すれば、その論理ビット170 個で表面符号用の 論理ビットを構成できる.

ここで、いずれの実験も希釈冷凍機を用いた極低温環境 下(~10 mK)で行われていることを指摘しておく、系の動 作周波数が5 GHz(温度換算で250 mK)付近なので、熱 揺らぎを十分に抑圧するためには、低温環境が必須である。 また、デバイスサイズは比較的大きい、これも動作周波数か らの要請であるが、5 GHzの電磁波の波長は真空中での6 cmであるから、そのための共振器はそれなりのサイズが必要 となる。コプレーナ線路ではメアンダ形状を用いるなどして、 多少コンパクトにすることができるが、それでも1量子ビット当 たり0.1~1 mmのスペースを必要とする。3次元共振器は cm のオーダである。希釈冷凍機の冷却能力・冷却スペースには 限界があることから、超伝導量子ビットに対しては QEC が実 現できるかとは別に、物理的なスケーラビリティに対して疑問 を呈する向きもある。

これに対して現在,冷却能力1mW程度で冷却スペースの 直径が40cm以上の無冷媒希釈冷凍機が市販されている. これだけでも数百量子ビットの動作に支障はないと思われる が、ニュートリノ天文学の分野では、直径90cm、高さ1m、 重量1.5tの検出器に2700本のワイヤをつなぎ、10mKまで 冷却して、10年間連続運用するための希釈冷凍機の開発さ え進行中である⁷⁸⁾.そのテストとして、1m³の空間を15日間 にわたって6mKに保持する実験がすで に行われている⁷⁹⁾.少なくとも現在の研 究フェーズで,希釈冷凍機の性能が大 きな制約になることはないと思われる.

3.4.1 スタビライザ符号

古典のエラー訂正符号をベースとした QEC の方式は、スタビライザ符号として 体系化されている⁸⁰⁾.例として、図 3 (a)に、任意のエラーを訂正することの できるスティーン符号の量子回路を示 す.7量子ビットで論理ビット $|0>_L$, $|1>_L$ を構成し、そこに生じるビットフリッ

プ, 位相フリップといったエラーを, 別の6量子ビット (ancilla, 補助ビットと呼ばれる)を用いて "診断"する. 重要なこ とは, 量子状態そのものを読まずに, 状態の組のパリティを読 むことである.

簡単な例として、論理ビットを $|0>_{L}=|000>$, $|1>_{L}=|111>$ と符号化することを考える. 任意の量子状態は、 $|\Psi>=c_{0}|000>+c_{1}|111>$ となる. このとき、1番めと2番 めのビット対(00または11)のパリティ、2番めと3番めの ビット対(00または11)のパリティはともに1である. 一番め のビットがフリップするエラーが起きると、状態は $|\Psi>=$ $c_{0}|100>+c_{1}|011>$ となるが、このとき、1番めと2番めの ビット対(10または01)のパリティは1である. このパリティ チェック(シンドローム測定と呼ばれる)から、1番めのビット をフリップすれば、エラー訂正できることになる. TU Delft グ ループは、この例を5量子ビット系で実装(論理ビットに3量 子ビット,補助ビットに2量子ビット)して、エラー検出までを 行っている⁸¹⁰.

スティーン符号の論理ビットを構成するには、まずは7量子 ビットが必要であるが、エラー耐性を上げるには、符号を入れ 子にして繰り返す必要がある.その都度、必要となる量子ビッ ト数、補助ビット数、測定回数は増大する.そうして、系がエ ラー耐性を獲得するために許容されるエラー率は、大ざっぱ な見積もりでも10⁻⁴ 程度、より詳しい解析では10⁻⁵~10⁻⁶ と 考えられている⁸⁰⁾.この要請を満たすことは、現時点の超伝 導量子ビットの性能からはまだ難しい.

3.4.2 表面符号

表面符号は、並進対称性を有するスタビライザ符号の一種 で、エラー率として1%程度まで許容する点で魅力的である. Google-UCSB グループがこの値を達成していることはすでに 述べた³⁷⁾.表面符号では、図3(b)のように、量子ビットを2 次元格子状に配置し、データビットのほかに、エラーを検出す るための2種類の測定ビットをデータビットに挟んで配置する. 最近接量子ビット間のゲートのみで量子計算ができる点で、 固体デバイスでの実装に有利である.図3(b)の破線枠は、 任意のエラー訂正が可能な論理ビットを構成するための最小 ブロックであるが,第2章で述べたように,エラー率と1論理 ビットを構成するのに必要な物理ビット数にはトレードオフがあ る.1%のエラー率では10⁴個もの物理ビットが必要となるが, まずは小さいブロックサイズで要素技術を確実にものにしていく ことが重要である.

IBM グループは,表面符号を念頭に量子ビットを2次元的 に配置しており^{82,83)},図3(b)の点線枠に相当するブロック (物理ビット×4+測定ビット×1)で重み4のパリティ測定 (ZZZZ またはXXXX)を実行している⁸⁴⁾.ZZZZのパリティ 測定を行うには,測定ビットを標的ビット,物理ビットの1つを 制御ビットとする制御 NOT ゲートを全ての物理ビットに対して 実行してから(CNOT×4)測定ビットを測定する.各物理ビット の初期状態として|0>,|1>のいずれかを与えると16通り のパターンがある(|0000>,|0001>,…,|1111>)が,各 入力に対して正しいパリティが得られる確率の平均は0.701で あった.XXXXで同様のパリティ測定を行うと,正しいパリ ティが得られる確率の平均は0.570であった.十分な値とはい えないが,今後へつながる重要な一歩である.

Google-UCSB グループのデバイスは 1 次元配列なので, 図 3(b)の一点鎖線枠の 5 量子ビットや,さらに横に増やした 9 量子ビットを実装している. 1 次元配列で直せるエラーはビッ トフリップだけであるが,Google-UCSB グループはこの場合の エラー訂正を実行している⁸⁵⁾. この実験では,構成要素の物 理ビットの T_1 は平均で 20 μ s であったのに対し,5 量子ビット に符号化してエラー訂正を実行するとその 2.7 倍に、9 量子 ビットで 8.5 倍に延伸されることが確認されている. 冗長性を 増やすことでエラー抑圧が改善されるという結果は,これが初 めてであり,極めて重要な成果である.

3.4.3 猫符号

猫符号は、共振器光子に量子状態を埋め込むというスタビ ライザ符号(表面符号を含む)とは異なるアプローチである. 猫符号の背景にあるアイデアは、高Q共振器では極めて長い 光子寿命を実現できるうえ、支配的な緩和過程は光子損失だ けなので、光子状態を量子メモリとして用いて光子損失イベン トを実時間追跡すれば、エラー検出・訂正できるであろうとい うものである.では、どのような光子状態を量子メモリとして使 えばよいか.その答えが猫状態である.

猫状態とは、コヒーレント状態 |α>の重ね合わせ状態のこ とをいい、

$$|C_{(i)\alpha}^{\pm}\rangle = (|(i)\alpha\rangle \pm |-(i)\alpha\rangle)/\sqrt{2} \tag{3}$$

のような状態である(規格化因子には注意を要するが,ここでは簡単のため 1/ $\sqrt{2}$ とおく). コヒーレント状態 |a> は,直感的には,位相空間の原点にある真空状態を a だけ変位させたもので,光子の消滅演算子 a(すなわち光子損失)の固有状態である(a|a>=a|a>).したがって,猫状態は光子損失に対して $a|C_{0a}^{\pm}>=(i)a|C_{0a}^{\mp}>$ と応答する.そこで,猫状態の重ね合わせとして | $\Psi>=c_0|C_a^{\pm}>+c_1|C_{1a}^{\pm}>$ を作る

と、 | Ψ > は光子損失により、

$$a^{4}(c_{0}|C_{\alpha}^{+} > + c_{1}|C_{i\alpha}^{+} >)$$

$$\propto a^{3}(c_{0}|C_{\alpha}^{-} > + ic_{1}|C_{i\alpha}^{-} >) \propto a^{2}(c_{0}|C_{\alpha}^{+} > - c_{1}|C_{i\alpha}^{+} >)$$

$$\propto a(c_{0}|C_{\alpha}^{-} > - ic_{1}|C_{i\alpha}^{-} >) \propto c_{0}|C_{\alpha}^{+} > + c_{1}|C_{i\alpha}^{+} >$$
(4)

と変化し、 α が十分に大きければ、光子損失1回ごとに { $|C_{0\alpha}^{\dagger}\rangle$ }と{ $|C_{0\alpha}^{\bullet}\rangle$ }というパリティの異なるサブスペースの間 を行き来することがわかる.つまり、量子ビットを $|0\rangle_{L}=|C_{\alpha}^{\dagger}\rangle$, $|1\rangle_{L}=|C_{\alpha}^{\dagger}\rangle$ と符号化して、光子損失イベ ントを実時間で追跡し、必要に応じて共振器内に光子を戻せ ば、量子状態を保護することができる.光子損失イベントは、 超伝導量子ビットを用いて QND 測定できる.

猫符号の優れた点は、1 論理ビットを構成するのに必要な 物理リソースが、共振器1個だけで済む点である.その代わ り、共振器内に多数の光子を収容することで、符号化に必要 な冗長性を確保している.また、最初の符号化の時点でαを 十分に大きく取っておけば、光子損失のたびにエラー訂正を 施さなくても4回ごとに元の状態に戻ってくる(αが小さけれ ばすぐに真空状態に近づいていくので、この限りではない).

イェール大グループは、このスキームをエラー訂正も含めて 実装し、量子状態を 320 µs にわたって保持することに成功し ている⁸⁶⁾. これは、系のトランズモンの寿命 17 µs、単一光子 状態の寿命 287 µs のいずれよりも長い. いうまでもなく、これ は容易な実験ではない. エラー訂正に至るまでに、100 個以 上の光子のコヒーレント状態・猫状態生成⁸⁷⁾、{ $|C_{0a}^+\rangle$ }と { $|C_{0a}^-\rangle$ }のサブスペース間の量子跳躍の QND 実時間追 跡⁸⁸⁾ などを行い、量子制御技術開発を積み重ねた結果であ る. また、QND 測定にはジョセフソンパラメトリック増幅器 (Josephson Parametric Amplifier: JPA)が、実時間追跡やエ ラー訂正には高速のフィードバック回路が必要であり、エンジ ニアリングの面でも非常に多くの最新技術が投入されている.

4. シリコンスピン量子ビットの開発状況

シリコンスピン量子ビットの魅力は、何よりも高度に洗練され たシリコン CMOS 製造技術との親和性である.QEC や量子ア ルゴリズムを実行するには、量子ビットの測定結果に応じて系 にフィードバックを与える古典回路(CMOS 集積回路)が不 可欠である.量子ビット自体の作製だけでなく、周辺回路も含 めて同一チップ上に作り込めることは、系をスケールアップして いく際には、大変な強みとなる.現在の開発状況は、数量子 ビットの量子操作が実現している段階なので、超伝導量子ビッ トに追いつくだけでもまだ長い道のりであるが、10年前に超伝 導量子ビット研究の現状を予想できた人がどれだけいたであろ うか.シリコン量子コンピュータのもつポテンシャルは、半導体 産業の盟主 Intel 社を動かした.2015年、Intel 社は、量子 コンピュータ開発に参入することを発表した。TU Delft の L. Vandersypen を中心とする量子テクノロジー研究センター (QuTech) に、10年間で 5000万ドルを投資し、Si/SiGe 量 子ドットによる集積型量子コンピュータの開発に取り組む. 米国 オレゴン州ポートランド市近郊の Intel 社試作ラインで 300 mm Si/SiGe エピウェーハと量子ドット構造を作製し,それを TU Delft グループが評価するというのが当面の計画であるが,超 伝導量子ビット研究における Google-UCSB グループのケース と同様に,産学の大物タッグがどのような結果をもたらすか大 変興味深い.

本章ではまず、シリコンスピン量子ビットの研究以前に、ヒ 化ガリウム (GaAs) 系の量子ドットにおいてどのような研究が 行われていたかを簡単に振り返り、その後、シリコン系の研究 動向を解説する.現在、シリコンスピン量子ビット研究では、 単一リンドナースピン、MOS 界面に形成される量子ドット中の スピン、Si/SiGe ヘテロ構造中の歪 Si 層に形成される量子 ドット中のスピンを用いる3つのアプローチがしのぎを削ってい るので、これらについて順に議論する.

4.1 シリコン以前

半導体量子輸送・低次元物性の研究においては、シリコン は"ダーティ"、GaAs 系材料は"クリーン"な系と見なされて きた. 整数量子ホール効果は、1980年にシリコン MOS 反転 層において発見されたが、その2年後に変調ドープ n-AlGaAs/GaAs ヘテロ界面で分数量子ホール効果が観測されて 以降は、研究の舞台は後者に移ってしまった。1978年に変調 ドープ法が導入されてから10年ほどの間に、AlGaAs/GaAs 2 次元電子ガス(2DEG)の移動度は、3桁以上向上し、1988 年には、量子ポイントコンタクト(QPC)のつくる1次元チャネ ルにおいて、コンダクタンスの量子化が発見されている。そし て1990年代は、0次元系(量子ドット)の研究が本格化する。

現在の量子コンピュータ研究に直接つながる研究は, 1996 年の NTT 物性科学基礎研究所の樽茶清悟(1998 年より東 京大学. 2012年より現・(国研)理化学研究所兼任), TU Delft の L. Kouwenhoven (量子化コンダクタンスの発見者の 1人) らによる、"縦型"量子ドットのエネルギースペクトルに おけるシェル構造の観測に始まる⁸⁹⁾. GaAs/AlGaAs/InGaAs/ AlGaAs/GaAs の2重障壁トンネルダイオード構造を、ドライ エッチングにより半径 100 nm 程度のピラー形状に微細加工す ることで、InGaAs 層に3次元の閉じ込めを実現した. ピラー 側面に配置したゲート電極により,量子ドット内の電子数を0 個から1,2,…個と順に制御することが可能となり、フント 則をはじめとする電子相関によるスピン効果が見えるようになっ た. 1998年には、スイス・バーゼル大学の D. Loss, IBM ワ トソン研究所の D. DiVincenzo による量子ドットスピン量子コン ピュータの提案90),豪州ニューサウスウェールズ大学 (UNSW)の B. Kane によるシリコンドナースピン量子コン ピュータの提案⁹¹⁾がなされ、半導体スピン量子コンピュータの 可能性が喧伝されるようになる.

Loss-DiVincenzo スキームでは、2量子ビットゲートは、近 接する量子ドット間のトンネル結合を制御することによって生じ る交換相互作用を用いる.縦型量子ドットの場合、トンネル結 合は障壁層(AlGaAs)のバンドオフセットと層厚によって決 まってしまうため, *in situ* での制御は容易ではない. 多量子 ビットへの拡張性の面でも、基板表面に微細加工したゲート 電極への電圧印加により静電的に形成される"横型"量子 ドットの利用が望ましい. 横型量子ドットにおいて,0個までの 電子数制御が可能となったのは2000年のことである⁹²⁾.以 降,量子ドットにおける少数電子スピンの研究は,横型量子 ドットが主流となっていく.

この時期,米国スタンフォード大学/IBM アルマデン研究 所で溶媒分子 NMR 量子計算の研究を行い,"15=5×3"の 素因数分解量子アルゴリズムを実行⁹³⁾して名を馳せた Vandersypen が,Kouwenhoven の TU Delft グループに加 わったことで,同グループにおける量子情報研究は加速する. TU Delft グループによる主な成果として,QPC 電荷計による 量子ドット内電子数の非破壊測定(2003 年)⁹⁴⁾,スピン-電 荷変換による単一電子スピンのシングルショット測定(2004 年)⁹⁵⁾,交流磁場(磁気共鳴)による単一電子スピンのコ ヒーレント制御(2006 年)⁹⁶⁾,スピン軌道相互作用と交流電 場を用いた単一電子スピンのコヒーレント制御(2007 年)⁹⁷⁾ などが挙げられる.一方,樽茶グループは,縦型2重量子 ドットにおけるパウリ閉塞の観測(2002 年)⁹⁸⁾,マイクロマグ ネットの傾斜磁場と交流電場を用いた単一電子スピン共鳴 (2008 年)^{99,100)}などの成果を挙げた.

2005年,米国ハーバード大学の J. Petta (2007年より米 国プリンストン大学), A. Yacoby, C. Marcus (2012 年よりデ ンマーク・コペンハーゲン大学ニールスボーア研究所)らは, 2 重量子ドットにおけるドット間交換相互作用の電圧パルスに よる制御を実現して、大いに注目された¹⁰¹⁾. これは、Loss-DiVincenzo スキームにおける2量子ビットゲートと見ることも, 2 重量子ドットのスピン1 重項 (Singlet: S) とスピン3 重項 (Triplet: T) 状態を量子ビットとする, ST 量子ビットのコヒー レント制御と見ることもできる. 単一電子スピンのコヒーレント 制御, すなわち, Loss-DiVincenzo スキームの1量子ビット ゲートが実現したのは2006年だから、その時点で、任意の 量子ゲートと測定を行うための要素技術はそろっていたことに なる. しかしながら、そこから直ちに系をスケールアップすると いうことにはならなかった. 1,2量子ビットケートの組み合わ せ¹⁰²⁾,2量子ビットケートと各ビット独立のシングルショット測 定の組み合わせ¹⁰³⁾が実現したのは, 2011年になってからで ある. これには技術的な難度のほかにも, GaAs 系材料自体 の問題も関係している.

研究の過程で明らかになったことは、GaAs 系材料における スピン軌道相互作用と超微細相互作用の影響である^{104~106)}. スピン軌道相互作用は、電場による電子スピン制御を可能とす る一方、スピン緩和の要因となる。超微細相互作用によって 電子スピンが感じる核磁場は、ST 量子ビットの量子ゲートに利 用できる¹⁰⁷⁾反面、デコヒーレンス要因となる。結果として、 量子コンピュータに求められる高いゲート忠実度を実現するこ とが難しい.いずれももろ刃の剣であるが,量子コンピュータ にとっては、メリットよりもデメリットのほうがはるかに大きく、母 体材料として GaAs 系材料を用いる限り逃れることができない (Al, Ga, As の全ての安定同位体が核スピンをもつ).スピン 軌道相互作用が弱く、母体核スピンを除去することが可能なシ リコンの出番である.天然シリコンは3種類の安定同位体から 構成され、その組成比は²⁸Si:²⁹Si:³⁰Si=92.2%:4.7%: 3.1%である.このうち²⁹Siのみが核スピン*I*=1/2を有する が、筆者の1人(伊藤)の実践してきた半導体同位体工学に より取り除くことができる¹⁰⁸⁾.バルクでは残留の²⁹Siを 50 ppm に、エピウェーハでも 800 ppm に抑えた試料が得られている.

研究の対象が電子の電荷(電流)からスピンに移ったとき, "ダーティ"なのは GaAs 系材料で, "クリーン"なのはシリコン なのであった.こうして,研究の舞台はシリコンへ移って (戻って?)いく.もちろん,GaAs 系量子ドットで開発されて きた量子制御技術は,シリコン量子ドットへも適用されて研究 の急速な進展を支えている.GaAs 系量子ドットは,その高品 質ゆえに,技術開発のテストベッドとして今後も重要な役割を 果たしていくものと考えられる.

4.2 単一リンドナー量子ビット

Kane スキームでは、リン原子をシリコン表面から深さ 25 nm のところに 20 nm 間隔で 1 列に並べて集積型量子コンピュー タを構築する⁹¹⁾.5 つの最外殻電子を有する V 族元素リン原 子で結晶格子中のシリコン原子を置換すると、4 つの電子が 共有結合に使われ、残りの 1 つの電子がリン原子核の正の電 荷によるクーロン力で結合する.イオン化エネルギーは 45 meV であるため、室温では結合が切れて伝導電子となるが、 10 K 以下では電子がリン原子核に束縛されて水素原子的に 振る舞う(デバイス動作は、超伝導量子ビット同様~10 mK).また、リンの安定同位体は ³¹P のみで、核スピン I=1/2を有する.したがって、シリコン中のリンは電子スピン S=1/2と核スピンI=1/2からなる4準位(2量子ビット)系 となる.制御性の高い電子スピンを演算に、コヒーレンス時間 の長い核スピンを量子メモリに用いることで量子計算を行うと いうのが Kane のアイデアである.

提案直後から、豪州では Kane 量子コンピュータを実現す るために、UNSW をはじめとする研究機関に多大な資金が投 入されてきた. 2000 年代は、この取り組みは、豪州外からは 無謀な賭けと見られていたように思われる. しかし、執念は実 り、2010 年に UNSW の A. Morello と A. Dzurak のグループ は、単一リン電子スピンのシングルショット測定を実現す る¹⁰⁹⁾. 用いられた手法は、原理としては 2004 年の GaAs 系 量子ドットでの実験⁹⁵⁾ と同じである. しかしながら、単一リン のイオン注入と、スピン状態測定用の SET 構造の作り込みな ど、デバイス作製の難度は極めて高い.

UNSW グループはこれを皮切りに、単一リン電子スピンおよび核スピンのコヒーレント制御に立て続けに成功する^{110,111)}. 電子スピンの T_2 は 206 μ s で、これは天然バルクシリコンでの



図4 (a)シリコンスビン量子ビットの *T*₂. 図 2 とは縦軸のスケールが 3 桁異 なることに注意.elec.:ドナー電子スビン, n0:中性ドナー核スビン, n+: イオン 化ドナー 核スピン.Donor¹¹²⁾, MOS¹²⁰⁾, s-Si¹²⁵⁾.(b), (c) MOS 型 2 量子ビットデバイスの断面構造と走査型電子顕微鏡写真(文献 121 より再掲).

値の 2/3 程度であった. また, 核スピンに対しては, 中性リン で3.5 ms, イオン化リン(リンから電子を意図的に取り除いた 状態) で 60 ms という値が得られている. リンが表面から 10 nm 程度の深さに位置しているため、デコヒーレンス要因として は、²⁹Si 核スピンによる磁場揺らぎ以外にも、SiO₂/Si 界面に 存在する電子スピン欠陥や近接する SET のゲート配線の影響 なども考えられる中、これは希望のもてる数値である.とはい え、このように複雑なデバイスでは、²⁹Si 核スピン以外の要因 が T2を制限するであろうという声も少なくなかった. これを検 証すべく第2世代のデバイスでは、筆者の1人(伊藤)が UNSW グループに提供した 4 inch 天然シリコンウェーハ上に 99.92 % 28Si 層を1 µm 気相成長したエピウェーハが用いられ た. 結果 T₂は, 電子スピンで 950 µs, 中性リン核スピンで $T_2 = 20.4 \text{ ms}$, イオン化リン核スピンで $T_2 = 1.75 \text{ s}$ と延伸され た (図 4(a))¹¹²⁾. 中性リン核スピンに対してダイナミカルデ カップリングを行った場合のT2は、35.6sという驚異的な値 であった. この優れたコヒーレンス特性により、リンの電子スピ ンと核スピンの量子もつれ生成(忠実度 96 % 以上)¹¹³⁾, Kane の提案どおりに電子スピンで演算を実行し、その結果を 核スピンで保持(80 ms)する量子メモリ実験¹¹⁴⁾,電子スピ ンとマイクロ波光子がコヒーレントに結合したドレスト状態での 実現¹¹⁵⁾など、種々の興味深い実験が実現している.

現状のデバイス構造は、スピン制御のためのマイクロ波照 射用のワイヤと読み出し用の SET が占めるスペースが大きく、 仮に、単一イオン注入¹¹⁶⁾や STM (Scanning Tunneling Microscope)リソグラフィ¹¹⁷⁾により、ドナーを1列に並べるこ とが可能であったとしても、各ドナーごとに SET を作り込むこ とは難しい.量子ビット数を増やすには、さらなるアイデアが 必要である.回路 QED を用いて、離れた位置のドナーを結 合させる方法が提案されている¹¹⁸⁾.マイクロ波に関しては、 Kane のオリジナルの提案に解決策が示されている.リンド ナー直上にゲート電極(Aゲートと呼ばれる)を置き,正の 電圧を印加してリン電子を電極方向に引っ張る(イオン化され ない程度に).リンの電子・核スピンの共鳴周波数は、リン原 子位置の電子の存在確率(超微細相互作用の大きさに比例) に依存するので、リン原子位置での電子の分布を変えること で、共鳴周波数を変えることができる.²⁸Si中の電子スピン共 鳴線幅は 1.8 kHz と狭いため、共鳴周波数を線幅の 3000 倍 も変調することができる.マイクロ波を一定周波数で照射し続 けて、電子スピン共鳴周波数を電気的にチューニングして共 鳴をオン・オフすることで、電子スピンをコヒーレント制御する 実験が行われている¹¹⁹⁾.この方法で得られた T² は、通常 の磁気共鳴と遜色ない値であった.これは周波数リソースの 点から極めて効率的である.マイクロ波開ワイヤを局所的に 作り込まなくても、グローバルなマイクロ波照射によって、個々 のスピンを独立に制御することができる.

4.3 MOS 界面に形成される量子ドット中のスピン

シリコン中の電子有効質量は、GaAs 中のそれより大きいた め、シリコンで少数電子量子ドットを実現するためには、GaAs の場合よりサイズを小さくする必要がある. UNSW グループ は、最先端の微細加工技術を用いてシリコンで必要とされる 直径 30 nm 未満の量子ドットを作製し、少数電子領域を実現 した¹²⁰⁾. ここでも²⁸Si エピウェーハが活躍し,量子ドット中に 閉じ込められた単一電子スピンに対して T₂=1.2 ms, 1 量子 ビットゲート忠実度 99.6%を記録している120). 極小の量子 ドットとはいえ、リンドナーを1列に並べることに比べれば、多 量子ビット化の難度は緩和される. そのスタートとなる2量子 ビットデバイスが、UNSW グループの作製した図 4(b), (c) である¹²¹⁾. ゲートG_{1~4}により2重量子ドットを形成し,それ ぞれのドットQ1,Q2中の電子スピンを量子ビットとして用いる. Q1の左が読み出し用 SET である. Q2の右のリザーバー R (Reservoir)は、2つの量子ドットに電子を供給する.上部ラ インがマイクロ波照射用ワイヤである. Loss-DiVincenzoス キームに従って、2量子ビットゲート(1量子ビットゲートと組み 合わせた CNOT ゲート)が実現された.

ドナースピン量子ビットほどではないにせよ,多量子ビット化 に向けた課題は過小評価できない.図4(b),(c)のデバイス では、 Q_1 はSETで直接読み出せるが、 Q_2 のスピンを読み出 すためには、まず Q_1 のスピンをSETで読み出して(すなわち Q_1 を空っぽにして)、 Q_2 のスピンを Q_1 、SETと順にシャトルし なければならない.この操作には、 G_{1-4} の微妙なゲート電圧 操作が必要となる.一方、現状では、各ドットごとに読み出し 用のSETを作り込むことは設計上困難であるうえに、 $Q_1 と Q_2$ の間の結合は常にオンである.結合をオフにするには、さらに 小さいゲート構造を用いなければならない.

これらの問題の解決は、プロセスも含めて CMOS 集積回路 技術の知見が活用できるだろう.応用物理・電子工学研究 者との連携が欠かせない. CMOS 作製技術を取り入れるのであ れば、既存の 300 mm ウェーハプロセスラインで量子ビットが作 製できることが望ましい. そのような研究にフランス・原子力・ 代替エネルギー庁 (CEA) のグループが取り組んでいる¹²²⁾.

4.4 Si/SiGe ヘテロ構造中の歪 Si 層に形成される 量子ドット中のスピン

MOS 界面には常磁性欠陥(有名な P_b 中心など)が存在 するので、スピン量子ビットの環境としては最適ではないかもし れない.量子ビットの場所を MOS 界面から離したいということ で開発が進むのが、界面から離れた位置にある歪 Si(s-Si)層 にスピン量子ビットを構成するアプローチである.薄さ数 nm の Si層を格子定数が Siより大きい SiGe 層で挟み込むと、Si層 は引っ張り応力を受けて歪 Si層を形成する.その場合でも、 量子ドットは表面ゲートにより静電的に形成されるため、歪 Si 層をあまり深い位置に置くことはできないが、数十 nm であれ ば界面欠陥の影響を逃れながら、直径 50 nm オーダの少数 電子量子ドットを形成できる.

Si/SiGe 構造を用いたスピン量子ビット作製のブレークス ルーが、米国 HRL 研究所が 2012 年に発表した ST 量子ビッ トである¹²³⁾. 従来, 歪 Si 近傍の SiGe 層に電子を供給する ためにn型ドーピングが行われてきたが、その場合にはイオン 化しないドーパントに束縛され続けた電子スピンの揺らぎが、 ラビ振動を観測できないほどに量子ドットのコヒーレンスを劣化 させていた.そこで HRL 研グループは、ドーピング層を取り 除き、試料全体を覆うグローバルゲート電極によりキャリヤを 誘起し、さらに局所ゲート電極を用いて歪 Si 層にトンネル結 合 2 重量子ドットを形成した. GaAs 系 2 重量子ドットと同様 のパルス電圧操作¹⁰¹⁾ により, ST 量子ビットのコヒーレント振 動の観測に成功した.ただし、この場合のコヒーレンスは、 $T_2^* = 360$ ns とまだ短かった¹²³⁾. その後, HRL 研グループは 歪 Si 層を ²⁸Si に置き換え,3 重量子ドット量子ビットを実装 し, T^{*}₂ として 6.4 µs を得ている¹²⁴⁾. 3 重量子ドット量子ビット では、横1列に並んだ3個の量子ドットに1個ずつ電子を格 納し, 隣り合う量子ドットを交換相互作用で結合させる. この ときの3電子のスピン状態のうちの2状態を量子ビットとして 用いている.

Si/SiGe 構造の単一電子スピン量子ビットには,TU Delft グ ループと樽茶グループが取り組んでいる.TU Delft グループ は,マイクロマグネットと振動電場を用いたスピン共鳴法によっ て,天然組成試料で $T_2^*=0.92 \,\mu s$, $T_2=40 \,\mu s^{125}$,1量子 ビットゲート忠実度 98%以上を得ている¹²⁶⁾.樽茶グループ も,天然組成試料で $T_2^*=2 \,\mu s$ を得ている¹²⁷⁾.もともとマイク ロマグネット法を開発した樽茶グループだけに,マグネットデ ザインの最適化がなされており,ラビ振動周波数は最高 35 MHz と,TU Delft グループや UNSW グループの量子ドットに おける結果よりも 10倍は速いスピン回転を実現している.高 速でスピンを制御できるほど T_2 時間内に実行できるゲート回 数が増えるので,量子計算に有利であることはいうまでもな い.1量子ビットゲート忠実度 99.6%を達成しており,デ チューニングに対してラビ振動をプロットした,いわゆるシェブ ロンパターンの実験データは、半導体スピン量子ビットとしては 大変明瞭である.

量子ビットの高品質化には、やはり歪²⁸Si層を用いることが 有効である.筆者の1人(伊藤)と名古屋大学の宇佐美徳 隆グループは共同でウェーハを作製し、それを受け取った世 界のさまざまなグループがデバイス作製と測定を開始してい る.多量子ビット化の面では、プリンストン大グループ (Petta)が Si/SiGe構造で9個の量子ドットを1列に並べ、 その向かいに読み出し用の3個の量子ドットを配置した12量 子ドットデバイスを実現している¹²⁸⁾.ドット形成条件の再現 性、ドットごとの均一性に優れるうえ、T₁として170 ms が得 られている. Intel 社とTU Delft グループが共同研究を進め ていることはすでに述べた.プリンストン大グループのデバイス や Intel 社の作製するであろうデバイスで、どこまでの量子制 御が可能となるか注目される.

Intel 社が量子コンピュータ研究に参入した理由は、シリコン CMOS の微細化による性能向上が難しいフェーズを迎えてい るためである.そこで、古典 CMOS と量子ビットを同じシリコ ンウェーハ上で集積し、結果としてシリコンチップの性能向上 を実現しようとしている.デバイスをより小さく高密度にして数 の力で計算能力を高めるのではなく、計算原理そのものを革 新するというパラダイムシフトへの挑戦である.また、超伝導 量子ビットが成功を収めている一因は、量子コンピュータのた めのデバイスは大きくてもかまわないという、ある意味の開き直 りが、発想の転換へとつながったからであろう.シリコンスピン 量子ビットの系でも、最先端の微細加工技術の恩恵を十分に 享受しつつ、より自由な発想が求められる段階にきているよう に思われる.この点でも、応用物理・電子工学研究者のアイ デアに期待したい.

5. むすび:展望

筆者の1人(伊藤)が量子コンピュータに関する発表を初 めて聴いたのは、理研シンポジウム「極限微小構造の物理と 制御(7) 一材料工学から見た量子コンピューティングの可能 性一」(1998年7月, 菅野卓雄·青柳克信·石橋幸治主 催,応用物理学会協賛)においてであった.シリコンドナー スピン量子コンピュータのスキームを発表したばかりの Kane が 基調講演を行った. Kane は翌日には慶應義塾大学を訪問 し、伊藤とシリコン同位体工学の可能性を議論した. 偶然で はあるが, その 1998 年は, NEC で世界初の固体量子ビット が誕生した年であり(論文発表は翌1999年), Google 社が 設立された年でもある. それからおよそ 20年,本稿で解説し たとおり、シリコンスピン量子ビットと超伝導量子ビットの研究 は大きく発展し, Google 社が量子コンピュータ開発に参入す るという当時は想像もつかなかったフェーズへ突入している. そのことを思えば、これからの20年を語ることは大変難しい. あまり欲張らず、今後5年ほどの間に何がなされるべきかに ついて、すでに述べたことのまとめと述べきれなかったことを 簡単に列挙して本稿を閉じたい.

超伝導量子ビットでは、QEC の実装が主眼であることは述 べたとおりだが、一方、QEC を実装しない数十~百量子ビッ トの量子コンピュータで、古典コンピュータではできないような タスクを実行させようという試み(図1の第2段階)が並行し て進んでいる. タスク自体に有用性があるかは別として、とも かく量子の優位性(quantum supremacy と呼ばれる)を実証 しようという試みである.現在のコンピュータシミュレーションで は、数十スピンの量子系の計算も困難であるから、この路線 の研究から(量子シミュレーションと似た形で)有益な応用が 出てくる可能性は十分にある. また, D-Wave 社の行っている 量子アニーリングを、コヒーレンスではるかに優れる超伝導量 子ビット (D-Wave 社デバイスの T₂ は 100 ns 程度と推定され ている)で実行したら、どの程度の改善が見られるか(見ら れないか)をテストすることも、"量子の力とは何か"を理解 する助けになるだろう¹²⁹⁾.結局のところ,我々はいまだ"量 子コンピュータはなぜ優れているか"という根本を、完全に理 解してはいない.

ハードウェア面で超伝導量子ビットとシリコンスピン量子ビットに共通する課題は、多数の量子ビットを配置するアーキテク チャと量子・古典回路のインタフェースをどう設計するかであ る. 100 量子ビット程度までであれば、古典回路は全て室温 下に置いても実行可能かもしれないが、そうだとしても、マイ クロ波源をはじめとする電子機器群を市販品で100 セットそろ えるよりは、必要な機能を集約した専用機器を設計・作製する ほうが現実的であろう. 量子ビット測定に用いられる JPA は低 温下に置かざるをえないので、1 台の JPA を複数の量子ビット で共用できるようなルーティング回路があれば効率的である.

もちろん、いずれ古典回路を低温下に配置するのであれ ば、多量子ビットデバイスのアーキテクチャを設計する時点で 古典回路のことも考慮するに越したことはない. アーキテク チャは QEC の実装方法に強く依存する面があり、多くの研究 グループが表面符号を念頭においている現状では、実質的に は2次元配列がデフォルトとなる. すると問題は古典回路をど こに置くかだが、量子ビットと同一平面に置くか(図5(a))、 量子ビットと別の層に置くかになる(図5(b)).例えば、 Google-UCSB グループのアーキテクチャの拡張性は、今のと ころ1次元方向のみなので,表面符号の本格的実装を目指 すとすれば、さらなる改良が求められる. この1年ほどの間に 多くの研究グループがスケーラブルなアーキテクチャに関して さまざまな提案を行っており^{71,77,130~133)},各グループの次期 戦略が明らかになってきている. こうした提案を実装して QEC を実現できるかが、次の5年間の大きな試金石となるだろう. イェール大グループも、スケーラブルなアーキテクチャを提案し ている¹³¹⁾が、基本的なコンセプトは図 5(c)のような、同軸 ケーブルでつながれた多数の空洞共振器内をマイクロ波が行 き交らといらものである. 1つのトランズモンが動作不良を起こ してもそのトランズモンのみ交換すればよいという点で、トラン ジスタ以前の真空管による計算機と似て いて面白い.

エラーに対して頑強な量子計算への アプローチとして、マヨラナフェルミオン を用いたトポロジカル量子計算が注目を 集めていることにも触れておこう.マヨラ ナフェルミオンとは、反粒子が自分自身 であるようなフェルミオンで、E. Majoranaによって定式化された¹³⁴⁾が、 現実の素粒子には見つかっていない.

凝縮系の準粒子素励起としてマヨラナ粒子を実現する系がい くつか提案されており、その1つとして有望視されているの が、s波超伝導体とスピン軌道相互作用を有する狭ギャップ 半導体ナノワイヤのハイブリッド系である。2012年、 Kouwenhoven 率いる TU Delft グループは、アルミニウム (Al) -アンチモン化インジウム(InSb)ナノワイヤハイブリッド デバイスで、準粒子としてのマヨラナ粒子(マヨラナ束縛状 態)に期待される、伝導度のゼロバイアスピークを初めて観 測した¹³⁵⁾.最近では、Marcus 率いるコペンハーゲン大グ ループが、分子線エピタキシ成長による極めて高品質のアルミ ニウム-ヒ化インジウム(InAs)ナノワイヤハイブリッドデバイス を実現し^{136,137)}、詳細な電気伝導測定により、マヨラナ束縛 状態の存在をほぼ疑いのないものとしている^{138,139)}.

Microsoft 社は、トポロジカル量子コンピュータを実現するべく、KouwenhovenとMarcusを雇い入れ、TU Delft、コペン ハーゲン大の各キャンパス内に自社の量子情報研究所 (Station Q)を設立した.実際にトポロジカル量子計算を行う ためには、2個のマヨラナ粒子の位置を交換する操作 (braidingと呼ばれる)を実現することが必須であり、この分 野における今後5年間の達成目標となるだろう.

最後になるが、ソフトウェア面での課題として、表面符号を 含むスタビライザ符号では、限られたセットの量子ゲート(専 門的には、クリフォード群に属するゲート)しか用いることがで きない点がある. 古典コンピュータを凌駕する計算を行うには、 非クリフォード群のゲートを別に準備する必要があることが知ら れており (Gottesman-Knill の定理⁸⁰⁾)、そのために膨大な数 の補助ビットが必要となる (この事情はマヨラナ粒子によるトポ ロジカル量子計算でも同様である). 非クリフォード群ゲートを 生成する効率のよいアルゴリズム、非クリフォード群ゲートの使 用回数を最小化する量子回路設計、さらには、表面符号より エラー許容度が高くかつ効率的な新たな QEC 方式の探索な どの理論研究が極めて重要である¹⁴⁰⁾.

謝 辞

本稿をまとめるにあたり、ご議論をいただいた東京大学の 中村泰信教授,藤井啓祐助教,沖縄科学技術大学院大学 の川上恵里加博士に感謝する.本研究は、科研費基盤研究 (S) No.26220602,スピントロニクス学術研究基盤と連携ネッ トワーク事業,(独)日本学術振興会研究拠点形成事業により



図5 量子・古典インタフェースの例.

支援された.

文 献

- 1) https://www.youtube.com/watch?v=R3UXNa37Z-4
- S. Debnath, N.M. Linke, C. Figgatt, K.A. Landsman, K. Wright, and C. Monroe: Nature 536, 63 (2016).
- 3)素川靖司,高橋義朗:応用物理 79,140 (2010).
- 4) 福原武:光学 44, 476 (2015).
- 5) 武田俊太郎, 古澤明:応用物理 83, 444 (2014).
- 6) 武居弘樹:応用物理 84, 434 (2015).
- 7) 蔡兆申:応用物理 78,3 (2009).
- 8) 山本喜久:応用物理 79,91 (2010).
- 9) 古澤明:応用物理 79, 119 (2010).
- 10) 石橋幸治, ディーコンラッセル, 飛田聡:応用物理 84, 428 (2015).
- 11) 長谷川俊夫:応用物理 79, 104 (2010).
- 12) 佐々木雅英:応用物理 79, 112 (2010).
- 13) 佐々木寿彦:応用物理 85, 105 (2016).
- 14) 末宗幾夫, 笹倉弘理, 浅野泰寛, 熊野英和:応用物理 81, 1029 (2012).
- 15) 早瀬潤子:応用物理 82,754 (2013).
- 16) 小坂英男:応用物理 83,928 (2014).
- 17) 末宗幾夫:応用物理 85, 193 (2016).
- 18) 大岩顕:応用物理 85,769 (2016).
- 19) 香取秀俊:応用物理 81,656 (2012).
- 20) 蔡兆申:応用物理 82, 592 (2013).
- 21) 金子晋久, 大江武彦:応用物理 83, 356 (2014).
- 22) 山口浩司:応用物理 81, 990 (2012).
- 23) 金本理奈:応用物理 82,760 (2013).
- 24) 野村政宏:応用物理 82,764 (2013).
- 25) 衞藤雄二郎, 平野琢也:応用物理 82,769 (2013).
- 26) 伊藤公平:応用物理 84,52 (2015).
- 27) 波多野睦子, 岩崎孝之, 山崎聡: 応用物理 85, 311 (2016).
- 28) 量子情報・物理クラスター:応用物理 79,700 (2010).
- 29) I. Buluta and F. Nori: Science 326, 108 (2009).
- 30) 西森秀稔,大関真之:量子コンピュータが人工知能を加速する(日経 BP 社, 2016).
- 31) M.H. Devoret and R.J. Schoelkopf: Science 339, 1169 (2013).
- 32) A.G. Fowler, M. Mariantoni, J.M. Martinis, and A.N. Cleland: Phys. Rev. A 86, 032324 (2012).
- 33) T. Kleinjung, K. Aoki, J. Franke, A.K. Lenstra, E. Thomé, J.W. Bos, P. Gaudry, A. Kruppa, P.L. Montgomery, D.A. Osvik, H. Riele, A. Timofeev, and P. Zimmermann: Advances in Cryptology—CRYPTO 2010, p. 333 (Springer, 2010).
- 34) C. Zalka: arXiv:quant-ph/0601097 (2006).
- 35) N.C. Jones, R. Van Meter, A.G. Fowler, P.L. McMahon, J. Kim, T.D. Ladd, and Y. Yamamoto: Phys. Rev. X 2, 031007 (2012).
- 36) R. Van Meter and C. Horsman: Commun. ACM 56, 84 (2013).
- 37) R. Barends, J. Kelly, A. Megrant, A. Veitia, D. Sank, E. Jeffrey, T.C. White, J. Mutus, A.G. Fowler, B. Campbell, Y. Chen, Z. Chen, B. Chiaro, A. Dunsworth, C. Neill, P.O'Malley, P. Roushan, A. Vainsencher, J. Wenner, A.N. Korotkov, A.N. Cleland, and J.M. Martinis: Nature 508, 500 (2014).
- 38) 上田正仁:現代量子物理学-基礎と応用-(培風館, 2004).

×12040/C.

- 39) M.H. Devoret, A. Wallraff, and J.M. Martinis: arXiv: cond-mat/0411174 (2004).
- 40) A.J. Leggett: Prog. Theor. Phys. Supplement 69, 80 (1980).
- 41) J.M. Martinis, M.H. Devoret, and J. Clarke: Phys. Rev. Lett. 55, 1543 (1985).
- 42) Y. Nakamura, C.D. Chen, and J.S. Tsai: Phys. Rev. Lett. 79, 2328 (1997).
- 43) Y. Nakamura, Yu. A. Pashkin, and J.S. Tsai: Nature 398, 786 (1999).
- 44) Y. Nakamura, Yu. A. Pashkin, and J.S. Tsai: Phys. Rev. Lett. 87, 246601 (2001).
- 45) Y. Nakamura, Yu. A. Pashkin, T. Yamamoto, and J.S. Tsai: Phys. Rev. Lett. 88, 047901 (2002).
- 46) J.M. Martinis, S. Nam, J. Aumentado, and C. Urbina: Phys. Rev. Lett. 89, 117901 (2002).
- 47) D. Vion, A. Aassime, A. Cottet, P. Joyez, H. Pothier, C. Urbina, D. Esteve, and M.H. Devoret: Science 296, 886 (2002).
- 48) I. Chiorescu, Y. Nakamura, C.J.P.M. Harmans, and J.E. Mooij: Science 299, 1869 (2003).
- 49) Yu. A. Pashkin, T. Yamamoto, O. Astafiev, Y. Nakamura, D.V. Averin, and J.S. Tsai: Nature 421, 823 (2003).
- T. Yamamoto, Yu. A. Pashkin, O. Astafiev, Y. Nakamura, and J.S. Tsai: Nature 425, 941 (2003).
- A. Blais, R.-S. Huang, A. Wallraff, S.M. Girvin, and R.J. Schoelkopf: Phys. Rev. A 69, 062320 (2004).
- 52) A. Wallraff, D.I. Schuster, A. Blais, L. Frunzio, R.-S. Huang, J. Majer, S. Kumar, S.M. Girvin, and R.J. Schoelkopf: Nature 431, 162 (2004).
- S. R.J. Schoelkopf, P. Wahlgren, A.A. Kozhevnikov, P. Delsing, and D.E. Prober: Science 280, 1238 (1998).
- 54) D.J. Reilly, C.M. Marcus, M.P. Hanson, and A.C. Gossard: Appl. Phys. Lett. 91, 162101 (2007).
- 55) A.A. Houck, D.I. Schuster, J.M. Gambetta, J.A. Schreier, B.R. Johnson, J. M. Chow, L. Frunzio, J. Majer, M.H. Devoret, S.M. Girvin, and R.J. Schoelkopf: Nature 449, 328 (2007).
- 56) O. Astafiev, K. Inomata, A.O. Niskanen, T. Yamamoto, Yu. A. Pashkin, Y. Nakamura, and J.S. Tsai: Nature 449, 588 (2007).
- 57) M. Hofheinz, E.M. Weig, M. Ansmann, R.C. Bialczak, E. Lucero, M. Neeley, A.D. O'Connell, H. Wang, J.M. Martinis, and A.N. Cleland: Nature 454, 310 (2008).
- 58) M. Hofheinz, H. Wang, M. Ansmann, R.C. Bialczak, E. Lucero, M. Neeley, A.D. O'Connell, D. Sank, J. Wenner, J.M. Martinis, and A.N. Cleland: Nature 459, 546 (2009).
- 59) T. Niemczyk, F. Deppe, H. Huebl, E.P. Menzel, F. Hocke, M.J. Schwarz, J.J. Garcia-Ripoll, D. Zueco, T. Hümmer, E. Solano, A. Marx, and R. Gross: Nat. Phys. 6, 772 (2010).
- 60) 中村泰信: 固体物理 48 (11), 63 (2013).
- 61) P. Forn-Díaz, J.J. García-Ripoll, B. Peropadre, J.-L. Orgiazzi, M.A. Yurtalan, R. Belyansky, C.M. Wilson, and A. Lupascu: Nat. Phys. 13, 39 (2017).
- 62) F. Yoshihara, T. Fuse, S. Ashhab, K. Kakuyanagi, S. Saito, and K. Semba: Nat. Phys. 13, 44 (2017).
- A. Wallraff, D.I. Schuster, A. Blais, L. Frunzio, J. Majer, M.H. Devoret, S. M. Girvin, and R.J. Schoelkopf: Phys. Rev. Lett. 95, 060501 (2005).
- 64) J. Majer, J.M. Chow, J.M. Gambetta, J. Koch, B.R. Johnson, J.A. Schreier, L. Frunzio, D.I. Schuster, A.A. Houck, A. Wallraff, A. Blais, M.H. Devoret, S.M. Girvin, and R.J. Schoelkopf: Nature 449, 443 (2007).
- 65) J.A. Schreier, A.A. Houck, J. Koch, D.I. Schuster, B.R. Johnson, J.M. Chow, J.M. Gambetta, J. Majer, L. Frunzio, M.H. Devoret, S.M. Girvin, and R.J. Schoelkopf: Phys. Rev. B 77, 180502 (R) (2008).
- 66) L. DiCarlo, J.M. Chow, J.M. Gambetta, L.S. Bishop, B.R. Johnson, D.I. Schuster, J. Majer, A. Blais, L. Frunzio, S.M. Girvin, and R.J. Schoelkopf: Nature 460, 240 (2009).
- 67) L. DiCarlo, M.D. Reed, L. Sun, B.R. Johnson, J.M. Chow, J.M. Gambetta, L. Frunzio, S.M. Girvin, M.H. Devoret, and R.J. Schoelkopf: Nature 467, 574 (2010).
- 68) H. Paik, D.I. Schuster, L.S. Bishop, G. Kirchmair, G. Catelani, A.P. Sears, B.R. Johnson, M.J. Reagor, L. Frunzio, L.I. Glazman, S.M. Girvin, M.H. Devoret, and R.J. Schoelkopf: Phys. Rev. Lett. **107**, 240501 (2011).
- 69) C. Wang, Y.Y. Gao, P. Reinhold, R.W. Heeres, N. Ofek, K. Chou, C. Axline, M. Reagor, J. Blumoff, K.M. Sliwa, L. Frunzio, S.M. Girvin, L. Jiang, M. Mirrahimi, M.H. Devoret, and R.J. Schoelkopf: Science 352,

1087 (2016).

- 70) C. Rigetti, J.M. Gambetta, S. Poletto, B.L.T. Plourde, J.M. Chow, A.D. Córcoles, J.A. Smolin, S.T. Merkel, J.R. Rozen, G.A. Keefe, M.B. Rothwell, M.B. Ketchen, and M. Steffen: Phys. Rev. B 86, 100506 (R) (2012).
- 71) J.M. Gambetta, J.M. Chow, and M. Steffen: npj Quantum Information 3, 2 (2017).
- 72) E. Lucero, R. Barends, Y. Chen, J. Kelly, M. Mariantoni, A. Megrant, P. O'Malley, D. Sank, A. Vainsencher, J. Wenner, T. White, Y. Yin, A.N. Cleland, and J.M. Martinis: Nat. Phys. 8, 719 (2012).
- 73) R. Barends, J. Kelly, A. Megrant, D. Sank, E. Jeffrey, Y. Chen, Y. Yin, B. Chiaro, J. Mutus, C. Neill, P. O'Malley, P. Roushan, J. Wenner, T.C. White, A.N. Cleland, and J.M. Martinis: Phys. Rev. Lett. **111**, 080502 (2013).
- 74) https://quantumexperience.ng.bluemix.net/
- 75) D. Alsina and J.I. Latorre: Phys. Rev. A 94, 012314 (2016).
- 76) S.J. Devitt: Phys. Rev. A 94, 032329 (2016).
- 77) R. Versluis, S. Poletto, N. Khammassi, N. Haider, D.J. Michalak, A. Bruno, K. Bertels, and L. DiCarlo: arXiv:1612.08208 (2016).
- 78) D. Schaeffer, A. Nucciotti, F. Alessandria, R. Ardito, M. Barucci, L. Risegari, G. Ventura, C. Bucci, G. Frossati, M. Olcese, and A. de Waard: J. Phys.: Conf. Ser. 150, 012042 (2009).
- 79) J.L. Ouellet: arXiv:1410.1560 (2014).
- M.A. Nielsen and I.L. Chuang: *Quantum Computation and Quantum Information* (Cambridge University Press, 2000).
- D. Risté, S. Poletto, M.-Z. Huang, A. Bruno, V. Vesterinen, O.-P. Saira, and L. DiCarlo: Nat. Commun. 6, 6983 (2015).
- 82) J.M. Chow, J.M. Gambetta, E. Magesan, D.W. Abraham, A.W. Cross, B.R. Johnson, N.A. Masluk, C.A. Ryan, J.A. Smolin, S.J. Srinivasan, and M. Steffen: Nat. Commun. 5, 4015 (2014).
- 83) A.D. Córcoles, E. Magesan, S.J. Srinivasan, A.W. Cross, M. Steffen, J.M. Gambetta, and J.M. Chow: Nat. Commun. 6, 6979 (2015).
- 84) M. Takita, A.D. Córcoles, E. Magesan, B. Abdo, M. Brink, A. Cross, J.M. Chow, and J.M. Gambetta: Phys. Rev. Lett. 117, 210505 (2016).
- 85) J. Kelly, R. Barends, A.G. Fowler, A. Megrant, E. Jeffrey, T.C. White, D. Sank, J.Y. Mutus, B. Campbell, Y. Chen, Z. Chen, B. Chiaro, A. Dunsworth, I.-C. Hoi, C. Neill, P.J.J. O'Malley, C. Quintana, P. Roushan, A. Vainsencher, J. Wenner, A.N. Cleland, and J.M. Martinis: Nature 519, 66 (2015).
- 86) N. Ofek, A. Petrenko, R. Heeres, P. Reinhold, Z. Leghtas, B. Vlastakis, Y. Liu, L. Frunzio, S.M. Girvin, L. Jiang, M. Mirrahimi, M.H. Devoret, and R.J. Schoelkopf: Nature 536, 441 (2016).
- 87) B. Vlastakis, G. Kirchmair, Z. Leghtas, S.E. Nigg, L. Frunzio, S.M. Girvin, M. Mirrahimi, M.H. Devoret, and R.J. Schoelkopf: Science 342, 607 (2013).
- 88) L. Sun, A. Petrenko, Z. Leghtas, B. Vlastakis, G. Kirchmair, K.M. Sliwa, A. Narla, M. Hatridge, S. Shankar, J. Blumoff, L. Frunzio, M. Mirrahimi, M.H. Devoret, and R.J. Schoelkopf: Nature 511, 444 (2014).
- 89) S. Tarucha, D.G. Austing, T. Honda, R.J. van der Hage, and L.P. Kouwenhoven: Phys. Rev. Lett. 77, 3613 (1996).
- 90) D. Loss and D.P. DiVincenzo: Phys. Rev. A 57, 120 (1998).
- 91) B.E. Kane: Nature 393, 133 (1998).
- 92) M. Ciorga, A.S. Sachrajda, P. Hawrylak, C. Gould, P. Zawadzki, S. Jullian, Y. Feng, and Z. Wasilewski: Phys. Rev. B 61, R16315 (R) (2000).
- 93) L.M.K. Vandersypen, M. Steffen, G. Breyta, C.S. Yannoni, M.H. Sherwood, and I.L. Chuang: Nature 414, 883 (2001).
- 94) J.M. Elzerman, R. Hanson, J.S. Greidanus, L.H. Willems van Beveren, S. De Franceschi, L.M.K. Vandersypen, S. Tarucha, and L.P. Kouwenhoven: Phys. Rev. B 67, 161308 (R) (2003).
- 95) J.M. Elzerman, R. Hanson, L.H. Willems van Beveren, B. Witkamp, L.M. K. Vandersypen, and L.P. Kouwenhoven: Nature 430, 431 (2004).
- 96) F.H.L. Koppens, C. Buizert, K.J. Tielrooij, I.T. Vink, K.C. Nowack, T. Meunier, L.P. Kouwenhoven, and L.M.K. Vandersypen: Nature 442, 766 (2006).
- 97) K.C. Nowack, F.H.L. Koppens, Yu. V. Nazarov, and L.M.K. Vandersypen: Science 318, 1430 (2007).
- 98) K. Ono, D.G. Austing, Y. Tokura, and S. Tarucha: Science 297, 1313 (2002).
- 99) M. Pioro-Ladrière, T. Obata, Y. Tokura, Y.-S. Shin, T. Kubo, K. Yoshida,

T. Taniyama, and S. Tarucha: Nat. Phys. 4, 776 (2008).

- 100) T. Obata, M. Pioro-Ladrière, Y. Tokura, Y.-S. Shin, T. Kubo, K. Yoshida, T. Taniyama, and S. Tarucha: Phys. Rev. B 81, 085317 (2010).
- 101) J.R. Petta, A.C. Johnson, J.M. Taylor, E.A. Laird, A. Yacoby, M.D. Lukin, C.M. Marcus, M.P. Hanson, and A.C. Gossard: Science 309, 2180 (2005).
- 102) R. Brunner, Y.-S. Shin, T. Obata, M. Pioro-Ladrière, T. Kubo, K. Yoshida, T. Taniyama, Y. Tokura, and S. Tarucha: Phys. Rev. Lett. 107, 146801 (2011).
- 103) K.C. Nowack, M. Shafiei, M. Laforest, G.E.D.K. Prawiroatmodjo, L.R. Schreiber, C. Reichl, W. Wegscheider, and L.M.K. Vandersypen: Science 333, 1269 (2011).
- 104) A.C. Johnson, J.R. Petta, J.M. Taylor, A. Yacoby, M.D. Lukin, C.M. Marcus, M.P. Hanson, and A.C. Gossard: Nature 435, 925 (2005).
- 105) F.H.L. Koppens, J.A. Folk, J.M. Elzerman, R. Hanson, L.H. Willems van Beveren, I.T. Vink, H.P. Tranitz, W. Wegscheider, L.P. Kouwenhoven, and L.M.K. Vandersypen: Science 309, 1346 (2005).
- 106) D.J. Reilly, J.M. Taylor, J.R. Petta, C.M. Marcus, M.P. Hanson, and A.C. Gossard: Science 321, 817 (2008).
- 107) S. Foletti, H. Bluhm, D. Mahalu, V. Umansky, and A. Yacoby: Nature Phys. 5, 903 (2009).
- 108) K.M. Itoh and H. Watanabe: MRS Commun. 4, 143 (2014).
- 109) A. Morello, J.J. Pla, F.A. Zwanenburg, K.W. Chan, K.Y. Tan, H. Huebl, M. Möttönen, C.D. Nugroho, C. Yang, J.A. van Donkelaar, A.D.C. Alves, D.N. Jamieson, C.C. Escott, L.C.L. Hollenberg, R.G. Clark, and A.S. Dzurak: Nature 467, 687 (2010).
- 110) J.J. Pla, K.Y. Tan, J.P. Dehollain, W.H. Lim, J.J.L. Morton, D.N. Jamieson, A.S. Dzurak, and A. Morello: Nature 489, 541 (2012).
- 111) J.J. Pla, K.Y. Tan, J.P. Dehollain, W.H. Lim, J.J.L. Morton, F.A. Zwanenburg, D.N. Jamieson, A.S. Dzurak, and A. Morello: Nature 496, 334 (2013).
- 112) J.T. Muhonen, J.P. Dehollain, A. Laucht, F.E. Hudson, R. Kalra, T. Sekiguchi, K.M. Itoh, D.N. Jamieson, J.C. McCallum, A.S. Dzurak, and A. Morello: Nat. Nanotechnol. 9, 986 (2014).
- 113) J.P. Dehollain, S. Simmons, J.T. Muhonen, R. Kalra, A. Laucht, F. Hudson, K.M. Itoh, D.N. Jamieson, J.C. McCallum, A.S. Dzurak, and A. Morello: Nat. Nanotechnol. 11, 242 (2016).
- 114) S. Freer, S. Simmons, A. Laucht, J.T. Muhonen, J.P. Dehollain, R. Kalra, F.A. Mohiyaddin, F.E. Hudson, K.M. Itoh, J.C. McCallum, D.N. Jamieson, A. S Dzurak, and A. Morello: Quantum Sci. Technol. 2, 015009 (2017).
- 115) A. Laucht, R. Kalra, S. Simmons, J.P. Dehollain, J.T. Muhonen, F.A. Mohiyaddin, S. Freer, F.E. Hudson, K.M. Itoh, D.N. Jamieson, J.C. McCallum, A.S. Dzurak, and A. Morello: Nat. Nanotechnol. 12, 61 (2016).
- 116) J. van Donkelaar, C. Yang, A.D.C. Alves, J.C. McCallum, C. Hougaard, B. C. Johnson, F.E. Hudson, A.S. Dzurak, A. Morello, D. Spemann, and D. N. Jamieson: J. Phys.: Condens. Matter 27, 154204 (2015).
- 117) S.R. Schofield, N.J. Curson, M.Y. Simmons, F.J. Rueβ, T. Hallam, L. Oberbeck, and R.G. Clark: Phys. Rev. Lett. 91, 136104 (2003).
- 118) G. Tosi, F.A. Mohiyaddin, H. Huebl, and A. Morello: AIP Adv. 4, 087122 (2014).
- 119) A. Laucht, J.T. Muhonen, F.A. Mohiyaddin, R. Kalra, J.P. Dehollain, S. Freer, F.E. Hudson, M. Veldhorst, R. Rahman, G. Klimeck, K.M. Itoh, D. N. Jamieson, J.C. McCallum, A.S. Dzurak, and A Morello: Sci. Adv. 1, e1500022 (2015).
- 120) M. Veldhorst, J.C.C. Hwang, C.H. Yang, A.W. Leenstra, B. de Ronde, J.P. Dehollain, J.T. Muhonen, F.E. Hudson, K.M. Itoh, A. Morello, and A.S. Dzurak: Nat. Nanotechnol. 9, 981 (2014).
- 121) M. Veldhorst, C.H. Yang, J.C.C. Hwang, W. Huang, J.P. Dehollain, J.T. Muhonen, S. Simmons, A. Laucht, F.E. Hudson, K.M. Itoh, A. Morello, and A.S. Dzurak: Nature 526, 410 (2015).
- 122) R. Maurand, X. Jehl, D. Kotekar-Patil, A. Corna, H. Bohuslavskyi, R. Laviéville, L. Hutin, S. Barraud, M. Vinet, M. Sanquer, and S. De Franceschi: Nat. Commun. 7, 13575 (2016).
- 123) B.M. Maune, M.G. Borselli, B. Huang, T.D. Ladd, P.W. Deelman, K.S. Holabird, A.A. Kiselev, I. Alvarado-Rodriguez, R.S. Ross, A.E. Schmitz,

M. Sokolich, C.A. Watson, M.F. Gyure, and A.T. Hunter: Nature 481, 344 (2012).

- 124) K. Eng, T.D. Ladd, A. Smith, M.G. Borselli, A.A. Kiselev, B.H. Fong, K. S. Holabird, T.M. Hazard, B. Huang, P.W. Deelman, I. Milosavljevic, A.E. Schmitz, R.S. Ross, M.F. Gyure, and A.T. Hunter: Sci. Adv. 1, e1500214 (2015).
- 125) E. Kawakami, P. Scarlino, D.R. Ward, F.R. Braakman, D.E. Savage, M.G. Lagally, M. Friesen, S.N. Coppersmith, M.A. Eriksson, and L.M.K. Vandersypen: Nat. Nanotechnol. 9, 666 (2014).
- 126) E. Kawakami, T. Jullien, P. Scarlino, D.R. Ward, D.E. Savage, M.G. Lagally, V.V. Dobrovitski, M. Friesen, S.N. Coppersmith, M.A. Eriksson, and L.M.K. Vandersypen: Proc. Natl. Acad. Sci. USA 113, 11738 (2016).
- 127) K. Takeda, J. Kamioka, T. Otsuka, J. Yoneda, T. Nakajima, M.R. Delbecq, S. Amaha, G. Allison, T. Kodera, S. Oda, and S. Tarucha: Sci. Adv. 2, e1600694 (2016).
- 128) D.M. Zajac, T.M. Hazard, X. Mi, E. Nielsen, and J.R. Petta: Phys. Rev. Applied 6, 054013 (2016).
- 129) S.J. Weber, G.O. Samach, D. Hover, S. Gustavsson, D.K. Kim, D. Rosenberg, A.P. Sears, F. Yan, J.L. Yoder, W.D. Oliver, and A.J. Kerman: arXiv:1701.06544 (2017).
- 130) D.J. Reilly: npj Quantum Information 1, 15011 (2015).
- 131) T. Brecht, W. Pfaff, C. Wang, Y. Chu, L. Frunzio, M.H. Devoret, and R.J. Schoelkopf: npj Quantum Information 2, 16002 (2016).
- 132) M. Veldhorst, H.G.J. Eenink, C.H. Yang, and A.S. Dzurak: arXiv:1609. 09700 (2016).
- 133) L.M.K. Vandersypen, H. Bluhm, J.S. Clarke, A.S. Dzurak, R. Ishihara, A. Morello, D.J. Reilly, L.R. Schreiber, and M. Veldhorst: arXiv:1612.05936 (2016).
- 134) E. Majorana:素粒子論研究 63, 149 (1981).
- 135) V. Mourik, K. Zuo, S.M. Frolov, S.R. Plissard, E.P.A.M. Bakkers, and L. P. Kouwenhoven: Science 336, 1003 (2012).
- 136) P. Krogstrup, N.L.B. Ziino, W. Chang, S.M. Albrecht, M.H. Madsen, E. Johnson, J. Nygård, C.M. Marcus, and T.S. Jespersen: Nat. Mater. 14, 400 (2015).
- 137) W. Chang, S.M. Albrecht, T.S. Jespersen, F. Kuemmeth, P. Krogstrup, J. Nygård, and C.M. Marcus: Nat. Nanotechnol. 10, 232 (2015).
- 138) S.M. Albrecht, A.P. Higginbotham, M. Madsen, F. Kuemmeth, T.S. Jespersen, J. Nygård, P. Krogstrup, and C.M. Marcus: Nature 531, 206 (2016).
- 139) M.T. Deng, S. Vaitiekėnas, E.B. Hansen, J. Danon, M. Leijnse, K. Flensberg, J. Nygård, P. Krogstrup, and C.M. Marcus: Science 354, 1557 (2016).
- 140) D. Gottesman: Nature 540, 44 (2016).

(2017年1月24日 受理)

Profile -



阿部 英介(あべ えいすけ)

2006 年慶應義塾大学院理工学研究科博士課程修了.博士 (理学).東京大学物性研究所助手,英国オックスフォード大学 博士研究員,独立行政法人理化学研究所創発物性科学研究セ ンター研究員などを経て現在,慶應義塾大学スピントロニクス研 究センター特任准教授.



伊藤公平(いとう こうへい)

1994 年米国カリフォルニア大学バークレー校より Ph. D. 95 年慶應義塾大学助手,専任講師,助教授を経て 07 年より教 授. 日本物理学会理事(02~04 年),物理系欧文誌刊行協会 理事(04~06 年),学術会議連携会員(11 年~),応用物 理学会理事(16 年~).